

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

# 産業用フォトカプラ

Industrial Photocoupler



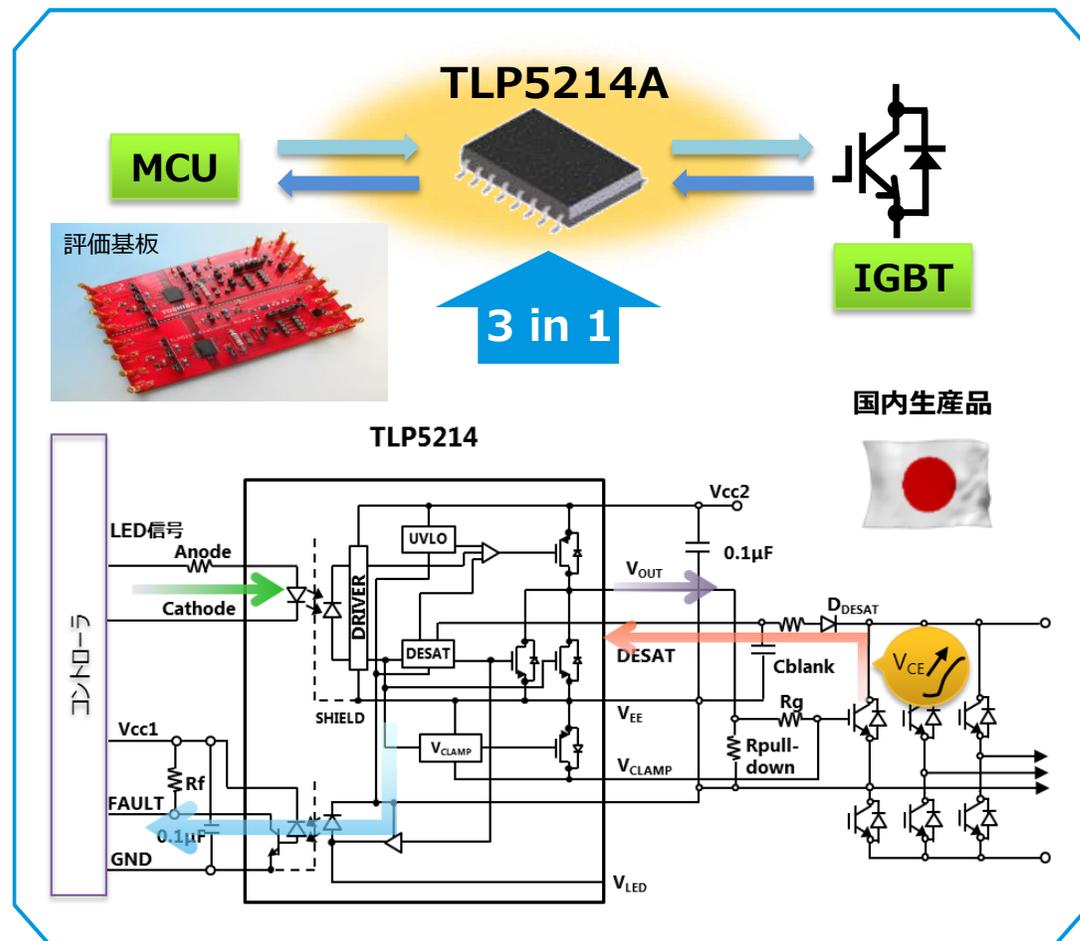
株式会社 **東芝** ストレージ&デバイスソリューション社

# スマートゲートドライバ TLP5214A

①絶縁ゲートドライブ ②IGBT過電流保護 ③フィードバック を薄型1PKGで実現

## 特長

- ピーク出力電流  $\pm 4\text{A}(\text{MAX})$
- IGBTコレクタ電圧不飽和検出 (ソフトターンオフ機能内蔵)
- アクティブミラークランプ<sup>o</sup>, UVLO
- フォルト信号フィードバック, R2R
- 出力伝播遅延時間  $150\text{ns}(\text{MAX})$
- 入出力間絶縁距離  $400\mu\text{m}(\text{MIN})$
- 絶縁耐圧  $5\text{kVrms}$ , 厚み  $2.3\text{mm}$



# アイソレーションアンプ TLP7820 / TLP7830 シリーズ

光絶縁方式の $\Delta\Sigma$  A/D変換回路内蔵アイソレーションアンプをラインアップ

## 特長

### ■ 新デジタル変調技術による低消費化

入力側消費電流=12mA(最大)

### ■ 高リニアリティ精度

アナログ出力品で0.02% (標準) @NL200

デジタル出力品で3LSB (標準) @INL

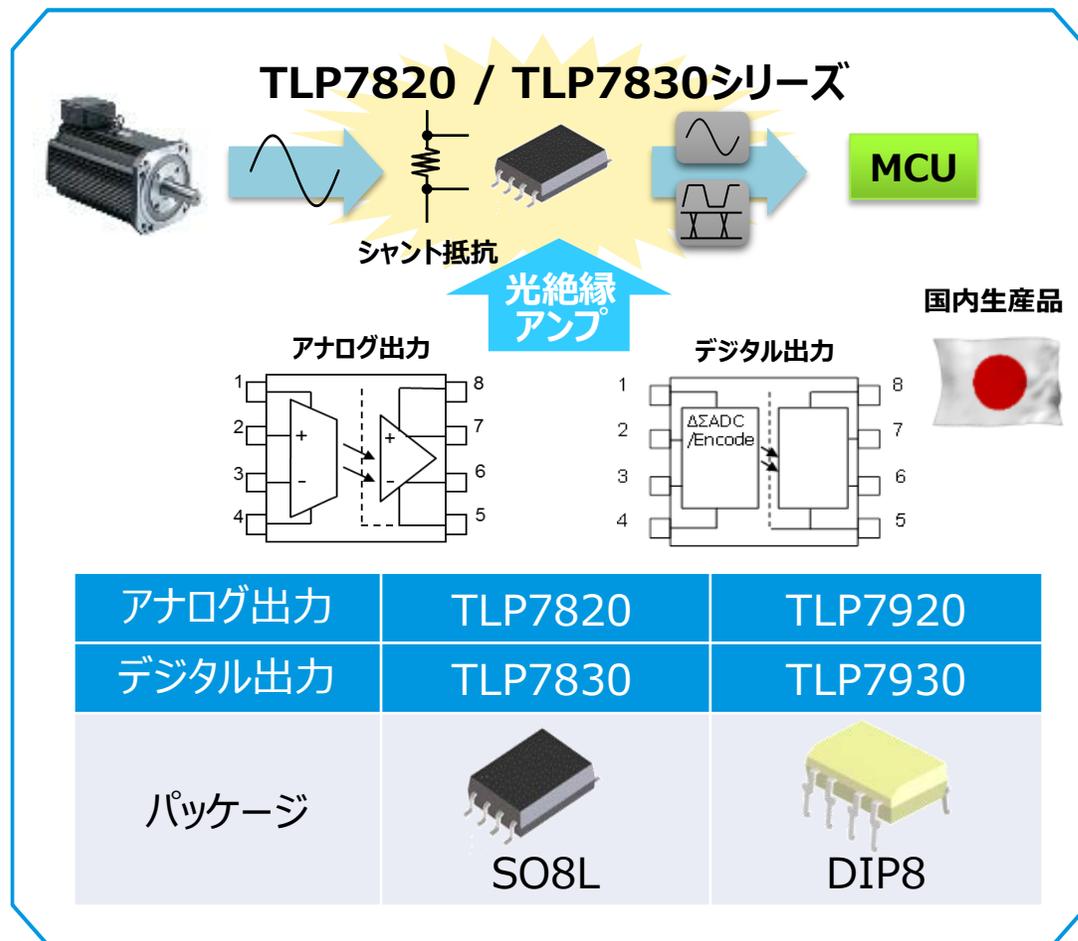
### ■ 高い同相過渡除去(CMTI)特性

20kV/ $\mu$ s(標準)

### ■ 高い絶縁耐圧と広い絶縁距離

BVs 5000Vrms(最小)

Iso-Gap, 400 $\mu$ m(最小)



# SO6LパッケージICカプラ LF4 リードフォーミング

## SO6L ICカプラにワイドリードフォーム オプション(LF4)を追加！

### 特長

- 当社SDIP6(Fタイプ)を直接互換
- 薄型低背パッケージで裏面実装に有利

製品実装高さ 2.3mm(最大)

### ■ 高絶縁耐圧

BVs 5000Vrms(最小)

### ■ パッケージパラメータ

沿面・空間距離 8mm(最小)

**SDIP F フォーミング** → **SO6L LF4**

Unit: mm

種類	製品	出力電流
ゲート ドライバ	TLP5701(LF4)	0.6 A
	TLP5702(LF4)	2.5 A
	TLP5751(LF4)	1.0 A
	TLP5752(LF4)	2.5 A
	TLP5754(LF4)	4.0 A

種類	製品	データレート
ロジック IC	TLP2704(LF4)	1Mbps
	TLP2761(LF4)	15Mbps
	TLP2768A(LF4)	20Mbps

# IGBT/MOS FET ゲートドライバカプラ

## 高速 Rail to Rail 出力 TLP5752シリーズ / TLP5772シリーズ

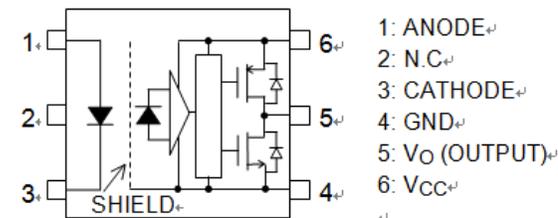
### 特長

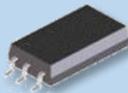
- Rail to Rail 出力
- 高速(tpHL/tpLH) 150ns(max.)
- 低スキュー ±80ns
- 消費電流(Icc) 3mA(max.)
- 動作温度 Topr:-40~110°C
- 薄型SO6L パッケージ

製品実装高さ 2.3mm(最大)

絶縁耐圧 5000Vrms(最小)

沿面・空間距離 8mm(最小)



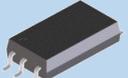
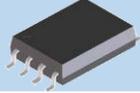
品名	TLP5751 TLP5752 TLP5754	TLP5771 TLP5772 TLP5774
パッケージ	SO6L 	
沿面・空間距離	8mm(min.)	
出力ピーク電流	±1.0/±2.5/±4.0A	
動作温度範囲	-40°C ~ 110°C	
電源電圧 (出力側)	15V ~ 30V	10V ~ 30V
消費電流 (出力側)	3mA (max.)	3mA (max.)
伝播遅延時間	150ns (max.)	150ns (max.)
スレッショルド入力電流	4mA (max.)	2mA (max.)

# 高速ロジックICカプラ

超低消費電力タイプから高速50MbpsやAC入力タイプまで幅広くラインアップ

## 特長

- 動作温度 Topr=-40~125 °C
- 東芝内製 高出力/高速 赤外発光LED
- 低消費 TLP2710/TLP2770
- 高速50Mbps TLP2767
- AC入力 TLP2395/TLP2398
- Vcc 30V TLP2745/TLP2748
- 汎用20Mbps TLP2768A

沿面・空間距離		5mm	8mm	8mm
絶縁耐圧		3750Vrms	5000Vrms	5000Vrms
データレート (typ.) Xbps=(1/2)XHz	出力方式			
		SO6	SO6L	SO8L-2ch
~50 M	Totem-pole	TLP2367	TLP2767	
~20 M	Open-Collector	TLP2368	TLP2768A	
	Totem-pole	TLP2366 TLP2370	TLP2770	TLP2270
~15M	Totem-pole	TLP2361	TLP2761	TLP2261
~10M	Open-Collector	TLP2362		
	Totem-pole	TLP2345 TLP2348	TLP2745 TLP2748	
	±Input	TLP2391		
~5 M	Totem-pole	TLP2355	TLP2710	
		TLP2358 TLP2310		
	±Input	TLP2395 TLP2398		

# 大電流フォトリレー

## DIP8パッケージと小型面実装パッケージでラインアップを拡充！

### 特長

- 無接点半導体リレー
- 1a接点 (ノーマリーオフタイプ)
- 薄型パッケージ  
TLP31XXシリーズ 2.1mm (最大)
- 省基板実装面積  
占有面積 27.3mm<sup>2</sup> (TLP3127)
- 600V耐圧品もラインアップ<sup>°</sup>  
TLP3549 600V DT MOS内蔵

型名	 TLP3127	TLP3107	 TLP3109
パッケージ	2.54SOP4	2.54SOP6	
出力側オフ電圧 VOFF (最大)	±60V		±100V
トリガLED電流 IFT (最大)	3 mA		
出力側オン電流 ION (最大)	±1.7A	±3.3A	±2.0A
出力側オン抵抗 RON (typ.)	0.08Ω	0.03Ω	0.07Ω
入出力間絶縁耐圧 BVs (最小)	1500 Vrms		
型名	TLP3547	TLP3548	TLP3549
パッケージ	 DIP8		
出力側オフ電圧 VOFF (最大)	±60V	±400V	±600V
出力側オン電流 ION (最大)	±5A	±0.4A	±0.6A
出力側オン抵抗 RON (typ.)	50mΩ	5000mΩ	2000mΩ
入出力間絶縁耐圧 BVs (最小)	2500 Vrms		

**TOSHIBA**

**Leading Innovation >>>**